

પ્રશ્ન 1(અ) [3 ગુણ]

સ્કેલિંગનું મહત્વ જણાવો

જવાબ:

સ્કેલિંગ semiconductor technology ને આગળ વધારવા અને device performance સુધારવા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.

સ્કેલિંગ ફાયદા	વર્ણન
Device Size	ઊંચી density માટે transistor dimensions ઘટાડે છે
Speed	ટૂંકી channel length થી ઝડપી switching
Power	પ્રતિ operation ઓછો power consumption
Cost	વધુ chips per wafer, function દીઠ ઓછો cost

- **Technology advancement:** Moore's Law ચાલુ રાખવામાં સક્ષમ બનાવે છે
- **Performance boost:** ઊંચી frequency operation શક્ય બનાવે છે
- **Market competitiveness:** નાના, ઝડપી, સસ્તા products

યાદરાખવાની ટિપ: "Small Devices Speed Progress Cheaply"

પ્રશ્ન 1(બ) [4 ગુણ]

Planar MOSFET અને FINFET ની તુલના કરો

જવાબ:

FinFET technology નાના nodes પર planar MOSFET ની મર્યાદાઓનો ઉકેલ આપે છે.

પેરામીટર	Planar MOSFET	FinFET
Structure	2D flat channel	3D fin-shaped channel
Gate Control	Single gate	Tri-gate/multi-gate
Short Channel Effects	નાના nodes પર ઊંચી	નોંધપાત્ર રીતે ઓછી
Leakage Current	ઊંચી subthreshold leakage	ખૂબ ઓછી leakage

- **Scalability:** FinFET sub-22nm technology nodes શક્ય બનાવે છે
- **Power efficiency:** FinFET વધુ સારો power-performance ratio આપે છે
- **Manufacturing:** FinFET વધુ જટિલ fabrication માંગે છે

યાદરાખવાની ટિપ: "Fins Control Current Better Than Flat"

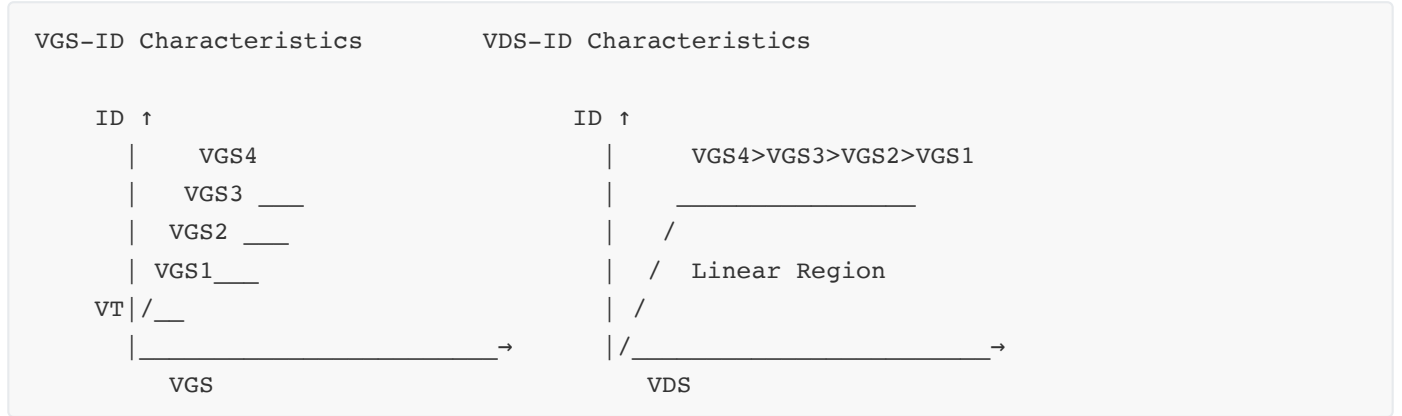
પ્રશ્ન 1(ક) [7 ગુણ]

N channel MOSFET ની VDS-ID અને VGS-ID લાક્ષણિકતાઓ દોરો અને સમજાવો

જવાબ:

N-channel MOSFET characteristics અલગ અલગ operating regions માં device behavior દર્શાવે છે.

આકૃતિ:



પ્રદેશ	સ્થિતિ	કરંટ સમીકરણ
Cutoff	$V_{GS} < V_T$	$I_D = 0$
Linear	$V_{DS} < (V_{GS} - V_T)$	$I_D \propto V_{DS}$
Saturation	$V_{DS} \geq (V_{GS} - V_T)$	$I_D \propto (V_{GS} - V_T)^2$

- થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ (V_T): conduction માટે લઘુત્તમ V_{GS}
- Transconductance: saturation માં V_{GS} - I_D curve નો slope
- આઉટપુટ પ્રતિકાર: saturation region માં વિપરીત slope

યાદરાખવાની ટિપ: "Threshold Gates Linear Saturation"

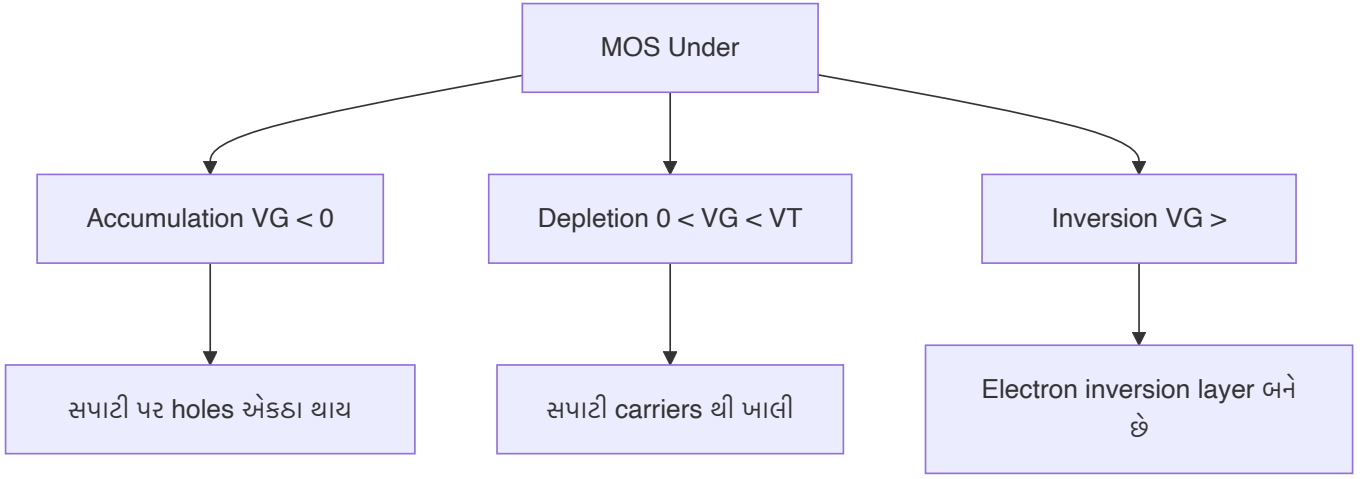
પ્રશ્ન 1(ક OR) [7 ગુણ]

એક્સટર્નલ બાયસ હેડળ MOS પર ઉદ્ભવતી અલગ અલગ અસર સમજાવો

જવાબ:

External bias અલગ અલગ charge distributions બનાવે છે જે MOS capacitor behavior ને અસર કરે છે.

આકૃતિ:



બાયસ સ્થિતિ	સપાટીની સ્થિતિ	કેપેસિટન્સ
Accumulation	સપાટી પર majority carriers	ઉંચી (Cox)
Depletion	કોઈ mobile carriers નથી	મધ્યમ
Inversion	Minority carriers channel બનાવે છે	ઉંચી (Cox)

- ફ્લેટ બેન્ડ વોલ્ટેજ: કોઈ charge separation અસ્તિત્વમાં નથી
- એનર્જી બેન્ડ બેન્ડિંગ: carrier distribution નક્કી કરે છે
- સપાટીનો વિલય: inversion layer formation નિયંત્રિત કરે છે

યાદરાખવાની ટિપ: "Accumulate, Deplete, then Invert"

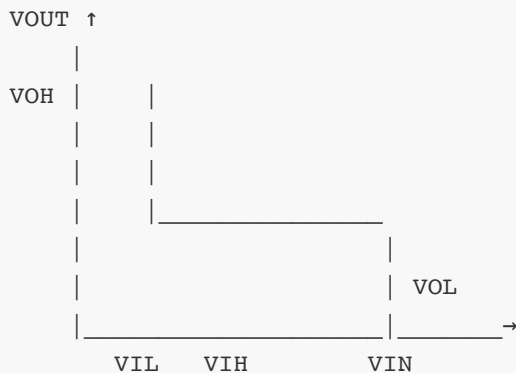
પ્રશ્ન 2(અ) [3 ગુણ]

આદર્શ ઇન્વર્ટરની વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફર લાક્ષણિકતા દોરો

જવાબ:

આદર્શ ઇન્વર્ટર infinite gain સાથે logic levels વચ્ચે તીક્ષ્ણ પરિવર્તન આપે છે.

આકૃતિ:



- તીક્ષ્ણ પરિવર્તન: switching point પર infinite slope
- નોઈઝ માર્જિન: $NMH = V_{OH} - V_{IH}$, $NML = V_{IL} - V_{OL}$
- સંપૂર્ણ લોજિક લેવલ: $V_{OH} = V_{DD}$, $V_{OL} = 0V$

ચાદરાખવાની ટિપ: "Sharp Switch, Perfect Levels"

પ્રશ્ન 2(બ) [4 ગુણ]

નોઈઝ ઇમ્યુનિટી અને નોઈઝ માર્જિન સમજાવો

જવાબ:

નોઈઝ ઇમ્યુનિટી circuit ની અનચાહેલા સિગ્નલ વેરિએશન ને નકારવાની ક્ષમતા માપે છે.

પેરામીટર	વ્યાખ્યા	ફોર્મ્યુલા
NMH	હાઈ-લેવલ નોઈઝ માર્જિન	$V_{OH} - V_{IH}$
NML	લો-લેવલ નોઈઝ માર્જિન	$V_{IL} - V_{OL}$
નોઈઝ ઇમ્યુનિટી	નોઈઝ નકારવાની ક્ષમતા	$\min(NMH, NML)$

- લોજિક થ્રેશોલ્ડ લેવલ: V_{IH} (input high), V_{IL} (input low)
- આઉટપુટ લેવલ: V_{OH} (output high), V_{OL} (output low)
- વધુ સારી ઇમ્યુનિટી: મોટા નોઈઝ માર્જિન વધુ સારી સુરક્ષા આપે છે
- ડિઝાઇન લક્ષ્ય: મજબૂત operation માટે નોઈઝ માર્જિન વધારવા

ચાદરાખવાની ટિપ: "Margins Protect Against Noise"

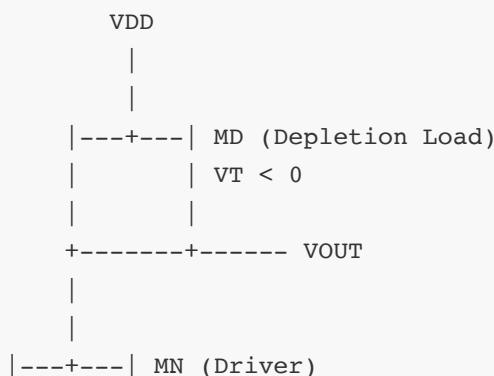
પ્રશ્ન 2(ક) [7 ગુણ]

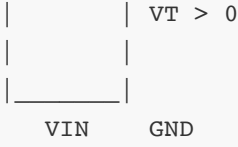
Saturated અને linear depletion load nMOS ઇન્વર્ટર સાથે ઇન્વર્ટર સર્કિટનું વર્ણન કરો

જવાબ:

Depletion load nMOS ઇન્વર્ટર active load resistor તરીકે depletion transistor વાપરે છે.

આકૃતિ:





લોડ પ્રકાર	ગેટ કનેક્શન	ઓપરેશન
Saturated Load	$V_G = V_D$	હંમેશા saturation માં
Linear Load	$V_G = V_{DD}$	Linear region માં કામ કરી શકે છે

- ડિપ્લીશન ડિવાઇસ: $V_{GS} = 0$ સાથે વહન કરે છે, current source તરીકે કામ કરે છે
- લોડ લાઇન વિશ્લેષણ: operating point intersection નક્કી કરે છે
- પાવર કન્ઝ્યુમ્પશન: હંમેશા વહન કરે છે, ઊંચો static power
- સ્વિચિંગ સ્પીડ: pull-up કરતાં pull-down ઝડપી

યાદરાખવાની ટિપ: "Depletion Loads Drive Outputs"

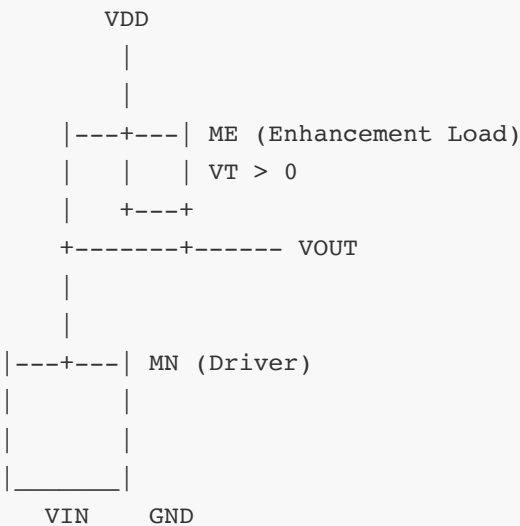
પ્રશ્ન 2(અ OR) [3 ગુણ]

એન્હાન્સમેન્ટ લોડ ઇન્વર્ટર દોરો અને સમજાવો

જવાબ:

Enhancement load ઇન્વર્ટર ખાસ biasing સાથે enhancement MOSFET ને load તરીકે વાપરે છે.

આકૃતિ:



- બૂટસ્ટ્રેપ કનેક્શન: લોડ માટે gate ને drain સાથે જોડાયેલ
- મર્યાદિત આઉટપુટ હાઈ: $V_{OUT(max)} = V_{DD} - V_T$
- થ્રેશોલ્ડ નુકસાન: Enhancement load વોલ્ટેજ ડ્રોપ કરાવે છે

યાદરાખવાની ટિપ: "Enhancement Loses Threshold"

પ્રશ્ન 2(બ OR) [4 ગુણ]

CMOS ઇન્વર્ટરના ફાયદા જણાવો

જવાબ:

CMOS technology NMOS ઇન્વર્ટર કરતાં શ્રેષ્ઠ performance આપે છે.

ફાયદો	લાભ
શૂન્ય સ્ટેટિક પાવર	steady state માં કોઈ current path નથી
રેલ-ટુ-રેલ આઉટપુટ	સંપૂર્ણ VDD અને 0V આઉટપુટ લેવલ
ઊંચી નોઈઝ ઇમ્યુનિટી	મોટા નોઈઝ માર્જિન
સમપ્રમાણ સ્વિચિંગ	બરાબર rise અને fall times

- પાવર એફિશિયન્સી: માત્ર switching દરમિયાન dynamic power
- સ્કેલેબિલિટી: બધા technology nodes પર સારી રીતે કામ કરે છે
- ફેન-આઉટ ક્ષમતા: અનેક inputs ડ્રાઇવ કરી શકે છે
- તાપમાન સ્થિરતા: performance તાપમાન પર ઓછી સંવેદનશીલ

યાદરાખવાની ટિપ: "CMOS Saves Power Perfectly"

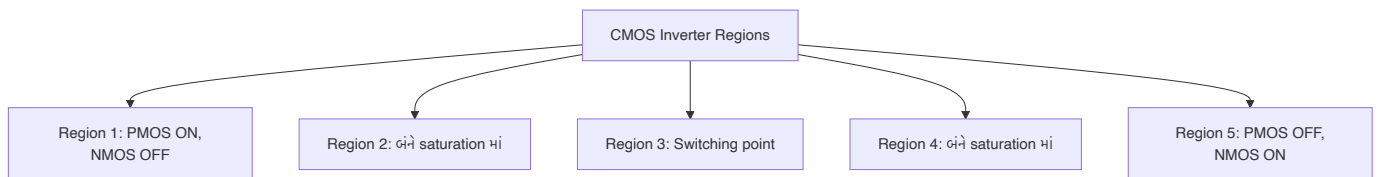
પ્રશ્ન 2(ક OR) [7 ગુણ]

CMOS ઇન્વર્ટરના ઓપરેટિંગ મોડ પ્રદેશ દોરો અને સમજાવો

જવાબ:

CMOS ઇન્વર્ટર operation input voltage ના આધારે પાંચ અલગ અલગ regions સમાવે છે.

આકૃતિ:



પ્રદેશ	NMOS સ્થિતિ	PMOS સ્થિતિ	આઉટપુટ
1	OFF	Linear	$VOH \approx VDD$
2	Saturation	Saturation	Transition
3	Saturation	Saturation	$VDD/2$
4	Saturation	Saturation	Transition
5	Linear	OFF	$VOL \approx 0V$

- સ્વિચિંગ થ્રેશોલ્ડ: VTC region 3 પર $VDD/2$ ને પાર કરે છે
- કરંટ ફ્લો: માત્ર transition regions 2,3,4 દરમિયાન
- નોઈઝ માર્જિન: Regions 1 અને 5 ઇમ્યુનિટી આપે છે
- ગેઇન: Region 3 માં મહત્તમ (switching point)

યાદરાખવાની ટિપ: "Five Regions Control CMOS Switching"

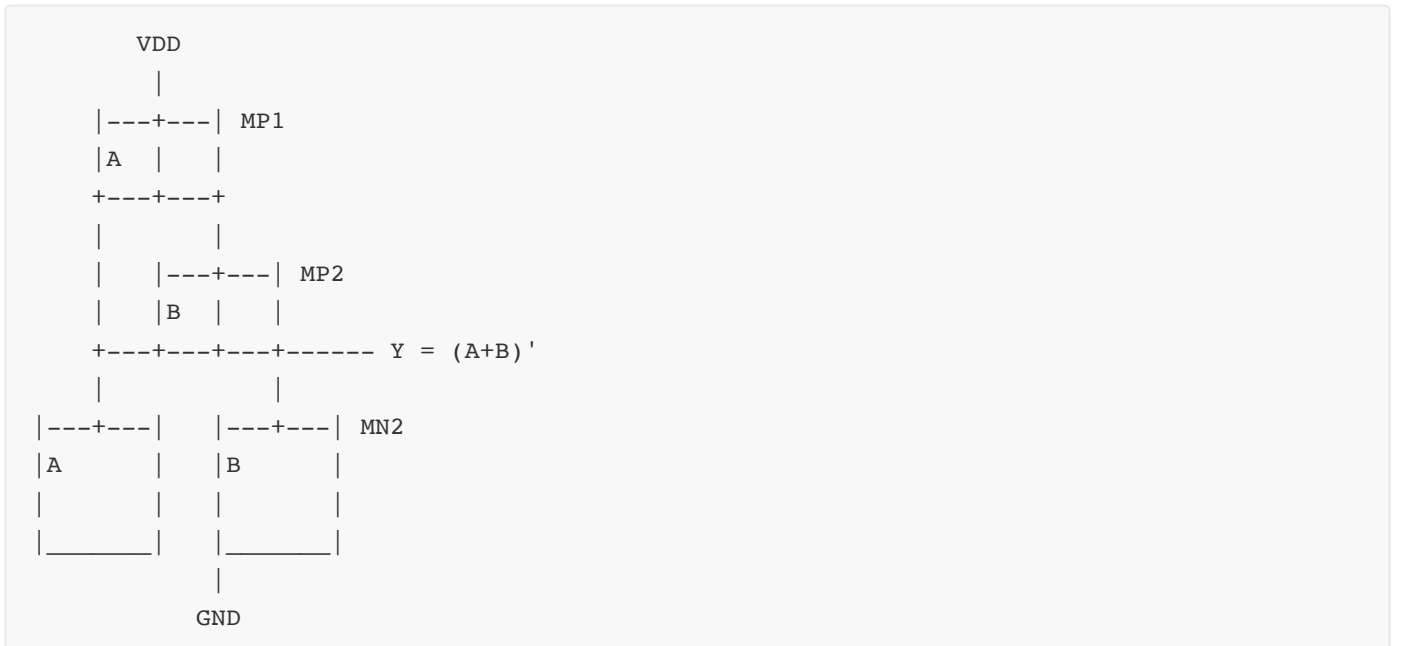
પ્રશ્ન 3(અ) [3 ગુણ]

CMOS વાપરીને બે ઇનપુટ NOR ગેટ દોરો

જવાબ:

CMOS NOR ગેટ complementary networks વાપરીને De Morgan's law અમલમાં મૂકે છે.

આકૃતિ:



- પુલ-અપ નેટવર્ક: સીરીઝ PMOS transistors (હાઈ આઉટપુટ માટે A અને B બંને લો)
- પુલ-ડાઉન નેટવર્ક: પેરેલલ NMOS transistors (લો આઉટપુટ માટે A અથવા B હાઈ)
- લોજિક ફંક્શન: $Y = (A+B)' = A' \cdot B'$

યાદરાખવાની ટિપ: "Series PMOS, Parallel NMOS"

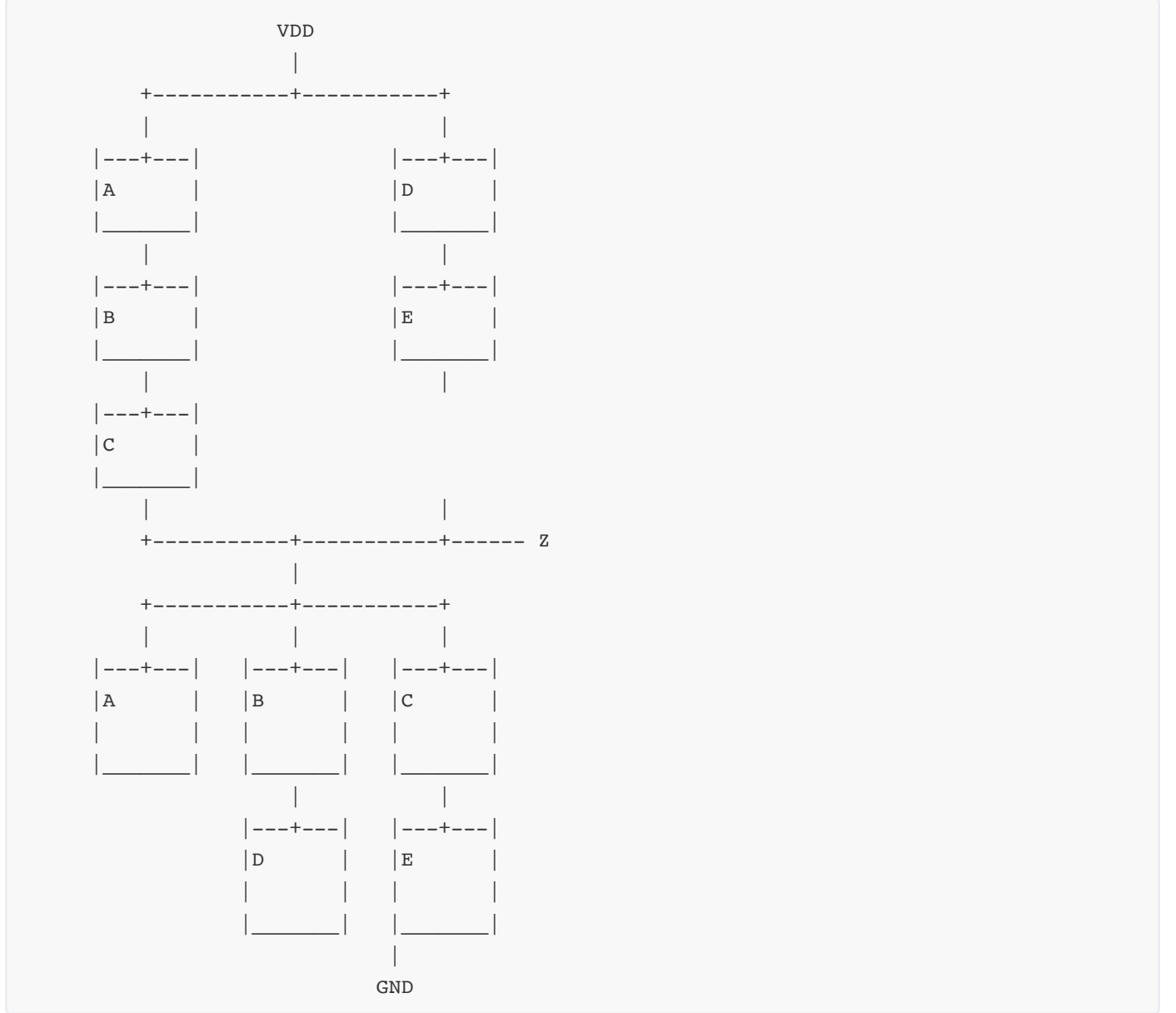
પ્રશ્ન 3(બ) [4 ગુણ]

CMOS વાપરીને બૂલિયન ફંક્શન $Z = [(A+B)C+DE]'$ અમલ કરો

જવાબ:

જટિલ CMOS લોજિક કાર્યક્ષમ અમલીકરણ માટે AOI (AND-OR-Invert) સ્ટ્રક્ચર વાપરે છે.

આકૃતિ:



- **AOI સ્ટ્રક્ચર:** કાર્યક્ષમ single-stage અમલીકરણ
- **ડ્યુઅલ નેટવર્ક:** કોમ્પ્લિમેન્ટરી pull-up અને pull-down
- **લોજિક ઓવિમાઇઝેશન:** અલગ ગેટ કરતાં ઓછા transistors

યાદરાખવાની ટિપ: "AOI Inverts Complex Logic Efficiently"

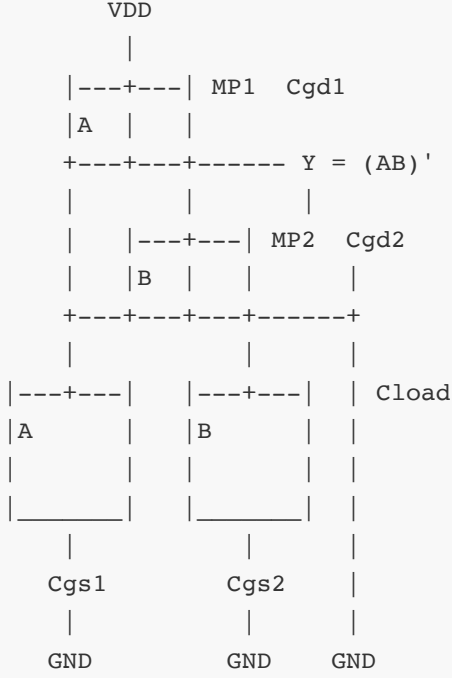
પ્રશ્ન 3(ક) [7 ગુણ]

પેરાસિટિક કિવાઇસ કેપેસિટન્સ સાથે CMOS NAND2 ગેટ દોરો અને સમજાવો

જવાબ:

CMOS ગેટમાં પેરાસિટિક કેપેસિટન્સ switching speed અને power consumption ને અસર કરે છે.

આકૃતિ:



પેરાસિટિક કેપેસિટન્સ:

Cgs - Gate to Source

Cgd - Gate to Drain

Cdb - Drain to Bulk

Csb - Source to Bulk

કેપેસિટન્સ	સ્થાન	અસર
Cgs	Gate-Source	Input capacitance
Cgd	Gate-Drain	Miller effect
Cdb	Drain-Bulk	Output loading
Csb	Source-Bulk	Source loading

- **સ્વિચિંગ વિલંબ:** પેરાસિટિક કેપેસિટન્સ transitions ધીમા કરે છે
- **પાવર કન્ઝ્યુમ્પશન:** પેરાસિટિક caps ચાર્જ/ડિસ્ચાર્જ કરવા
- **મિલર ઇફેક્ટ:** Cgd feedback બનાવે છે, switching ધીમું કરે છે
- **લેઆઉટ ઓપ્ટિમાઇઝેશન:** પેરાસિટિક કેપેસિટન્સ ઓછા કરવા

યાદરાખવાની ટિપ: "Parasitics Slow Gates Down"

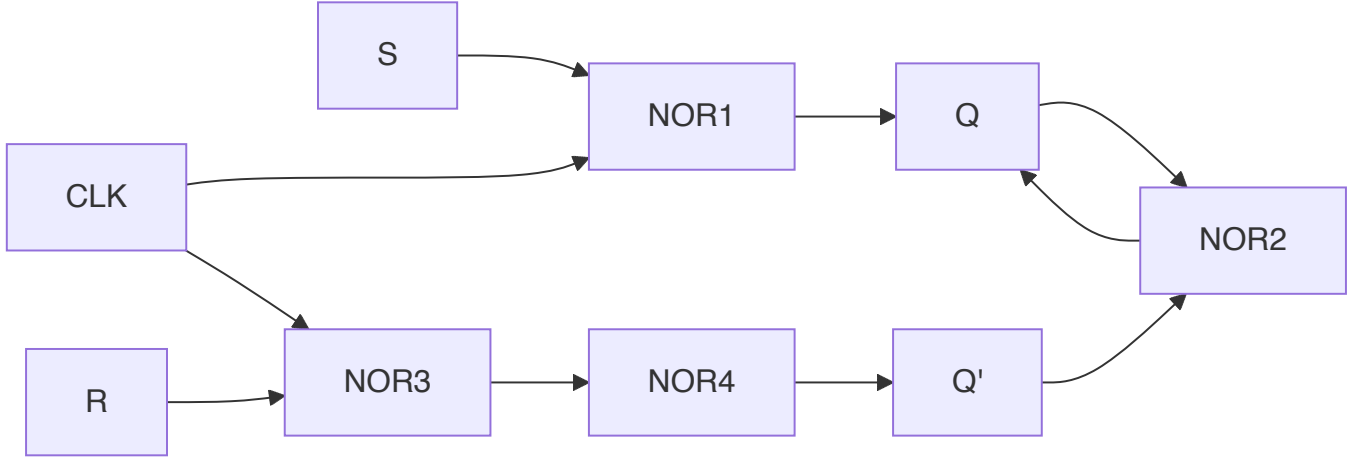
પ્રશ્ન 3(અ OR) [3 ગુણ]

CMOS વાપરીને NOR આધારિત Clocked SR latch દોરો અને સમજાવો

જવાબ:

Clocked SR latch synchronous operation માટે clock enable સાથે NOR gates વાપરે છે.

આકૃતિ:



- કલોક કંટ્રોલ: S અને R માત્ર CLK = 1 હોય ત્યારે જ અસરકારક
- ટ્રાન્સપેરન્ટ મોડ: clock સક્રિય હોય ત્યારે આઉટપુટ input ને અનુસરે છે
- હોલ્ડ મોડ: clock નિષ્ક્રિય હોય ત્યારે આઉટપુટ સ્થિતિ જાળવે છે
- મૂળભૂત બિલ્ડિંગ બ્લોક: flip-flops માટે પાચો

યાદરાખવાની ટિપ: "Clock Controls Transparent Latching"

પ્રશ્ન 3(બ OR) [4 ગુણ]

CMOS વાપરીને બૂલિયન ફંક્શન $Z=[AB+C(D+E)]'$ અમલ કરો

જવાબ:

આ ફંક્શન AOI લોજિક સ્ટ્રક્ચર વાપરીને inverted sum-of-products અમલમાં મૂકે છે.

લોજિક વિશ્લેષણ:

- મૂળ: $Z = [AB + C(D+E)]'$
- વિસ્તૃત: $Z = [AB + CD + CE]'$
- અમલીકરણ: ત્રણ AND terms NOR ને આપવામાં આવે છે

ટર્મ	ઇનપુટ્સ	ફંક્શન
ટર્મ 1	A, B	AB
ટર્મ 2	C, D	CD
ટર્મ 3	C, E	CE
આઉટપુટ	બધા terms	$(AB + CD + CE)'$

- **AOI અમલીકરણ:** સિંગલ સ્ટેજ, કાર્યક્ષમ ડિઝાઇન
- **ટ્રાન્ઝિસ્ટર કાઉન્ટ:** અલગ ગેટ અમલીકરણ કરતાં ઓછા
- **પરફોર્મન્સ:** ઝડપી switching, ઓછો power

યાદરાખવાની ટિપ: "Three AND Terms Feed One NOR"

પ્રશ્ન 3(ક OR) [7 ગુણ]

ઉદાહરણ સાથે AOI અને OAI લોજિકને અલગ પાડો

જવાબ:

AOI અને OAI કાર્યક્ષમ CMOS અમલીકરણ માટે પૂરક લોજિક પરિવારો છે.

પેરામીટર	AOI (AND-OR-Invert)	OAI (OR-AND-Invert)
સ્ટ્રક્ચર	AND gates \rightarrow OR \rightarrow Invert	OR gates \rightarrow AND \rightarrow Invert
ફંક્શન	$(AB + CD + \dots)'$	$((A+B)(C+D)\dots)'$
PMOS નેટવર્ક	Series-parallel	Parallel-series
NMOS નેટવર્ક	Parallel-series	Series-parallel

AOI ઉદાહરણ: $Y = (AB + CD)'$

PMOS: Series A-B parallel with Series C-D
 NMOS: Parallel A,B series with Parallel C,D

OAI ઉદાહરણ: $Y = ((A+B)(C+D))'$

PMOS: Parallel A,B series with Parallel C,D
 NMOS: Series A-B parallel with Series C-D

- **ડિઝાઇન પસંદગી:** બૂલિયન ફંક્શન ફોર્મ આધારે પસંદ કરો
- **ઓપ્ટિમાઇઝેશન:** ટ્રાન્ઝિસ્ટર કાઉન્ટ અને વિલંબ ઓછો કરે છે
- **દ્વૈતતા:** AOI અને OAI De Morgan duals છે

યાદરાખવાની ટિપ: "AOI ANDs then ORs, OAI ORs then ANDs"

પ્રશ્ન 4(અ) [3 ગુણ]

વ્યાખ્યા આપો: 1) Regularity 2) Modularity 3) Locality

જવાબ:

VLSI જટિલતાને સંચાલિત કરવા અને સફળ અમલીકરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ડિઝાઇન હાયરાર્કી સિદ્ધાંતો આવશ્યક છે.

સિદ્ધાંત	વ્યાખ્યા	ફાયદો
Regularity	સમાન સ્ટ્રક્ચર્સનો વારંવાર ઉપયોગ	સરળ લેઆઉટ, ટેસ્ટિંગ
Modularity	ડિઝાઇનને નાના બ્લોક્સમાં વહેંચવું	સ્વતંત્ર ડિઝાઇન, પુનઃઉપયોગ
Locality	મોટે ભાગે સ્થાનિક interconnections	ઓછી routing જટિલતા

- **ડિઝાઇન કાર્યક્ષમતા:** સિદ્ધાંતો ડિઝાઇન સમય અને પ્રયાસ ઘટાડે છે
- **વેરિફિકેશન:** મોડ્યુલર અભિગમ ટેસ્ટિંગ સરળ બનાવે છે
- **સ્કેલેબિલિટી:** મોટા, વધુ જટિલ ડિઝાઇન્સ શક્ય બનાવે છે

યાદરાખવાની ટિપ: "Regular Modules Stay Local"

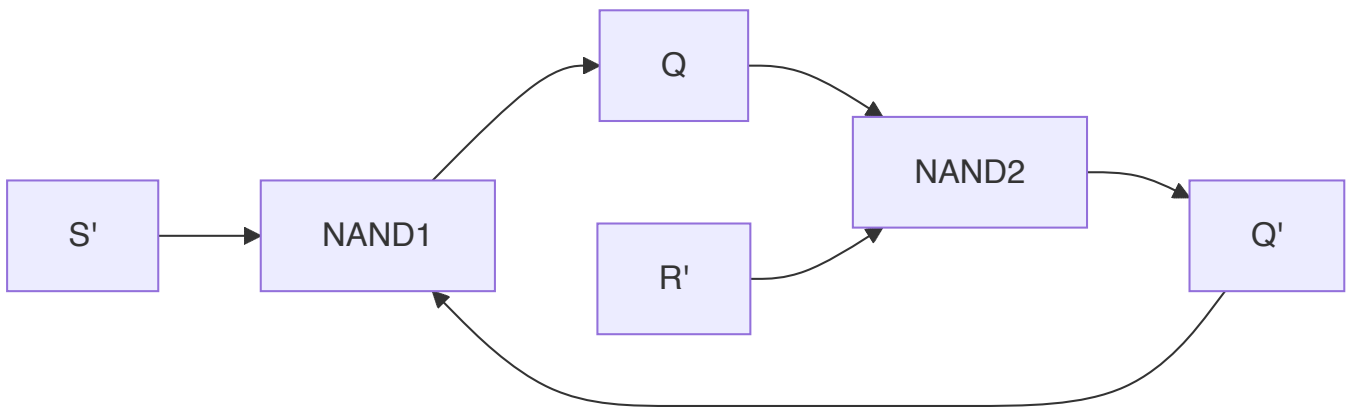
પ્રશ્ન 4(બ) [4 ગુણ]

CMOS ઇન્વર્ટર વાપરીને SR latch (NAND ગેટ) અમલ કરો

જવાબ:

NAND ગેટ વાપરીને SR latch active-low inputs સાથે set-reset functionality આપે છે.

આકૃતિ:



સત્ય કોષ્ટક:

S'	R'	Q	Q'	સ્થિતિ
0	1	1	0	Set
1	0	0	1	Reset
1	1	Q	Q'	Hold
0	0	1	1	અમાન્ય

- **ક્રોસ-કપ્લડ સ્ટ્રક્ચર:** મેમરી ફંક્શન આપે છે
- **એક્ટિવ-લો ઇનપુટ્સ:** S' = 0 સેટ કરે છે, R' = 0 રીસેટ કરે છે
- **પ્રતિબંધિત સ્થિતિ:** બંને ઇનપુટ્સ એકસાથે લો

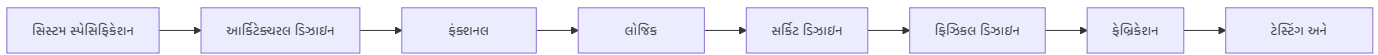
યાદરાખવાની ટિપ: "Cross-Coupled NANDS Remember State"

પ્રશ્ન 4(ક) [7 ગુણ]

VLSI ડિઝાઇન ફ્લો સમજાવો

જવાબ:

VLSI ડિઝાઇન ફ્લો specification થી fabrication સુધીના વ્યવસ્થિત પગલાંઓ અનુસરે છે.



લેવલ	પ્રવૃત્તિઓ	આઉટપુટ
સિસ્ટમ	આવશ્યકતા વિશ્લેષણ	સ્પેસિફિકેશન્સ
આર્કિટેક્ચર	બ્લોક-લેવલ ડિઝાઇન	સિસ્ટમ આર્કિટેક્ચર
લોજિક	બૂલિયન ઓપ્ટિમાઇઝેશન	ગેટ નેટલિસ્ટ
સર્કિટ	ટ્રાન્ઝિસ્ટર સાઇઝિંગ	સર્કિટ નેટલિસ્ટ
ફિઝિકલ	લેઆઉટ, routing	GDSII ફાઇલ

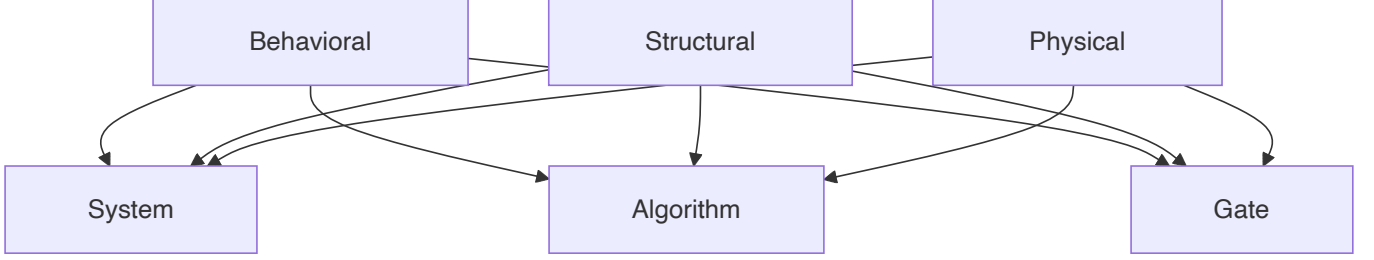
- **ડિઝાઇન વેરિફિકેશન:** દરેક લેવલે માન્યતા જરૂરી
- **પુનરાવર્તન:** ઓપ્ટિમાઇઝેશન માટે ફીડબેક લૂપ્સ
- **CAD ટૂલ્સ:** જટિલ ડિઝાઇન્સ માટે ઓટોમેશન આવશ્યક
- **ટાઇમ-ટુ-માર્કેટ:** કાર્યક્ષમ ફ્લો ડિઝાઇન સાયકલ ઘટાડે છે

યાદરાખવાની ટિપ: "System Architects Love Circuit Physical Fabrication"

પ્રશ્ન 4(અ OR) [3 ગુણ]

Y-ચાર્ટ દોરો અને સમજાવો**જવાબ:**

Y-ચાર્ટ VLSI ડિઝાઇનમાં ત્રણ ડિઝાઇન સોમેન અને તેમના abstraction levels દર્શાવે છે.

આકૃતિ:

- ત્રણ સોમેન: Behavioral (ફંક્શન), Structural (components), Physical (geometry)
- એબ્સ્ટ્રેક્શન લેવલ: System → Algorithm → Gate → Circuit → Layout
- ડિઝાઇન પદ્ધતિ: સમાન abstraction level પર સોમેન વચ્ચે ફરવું

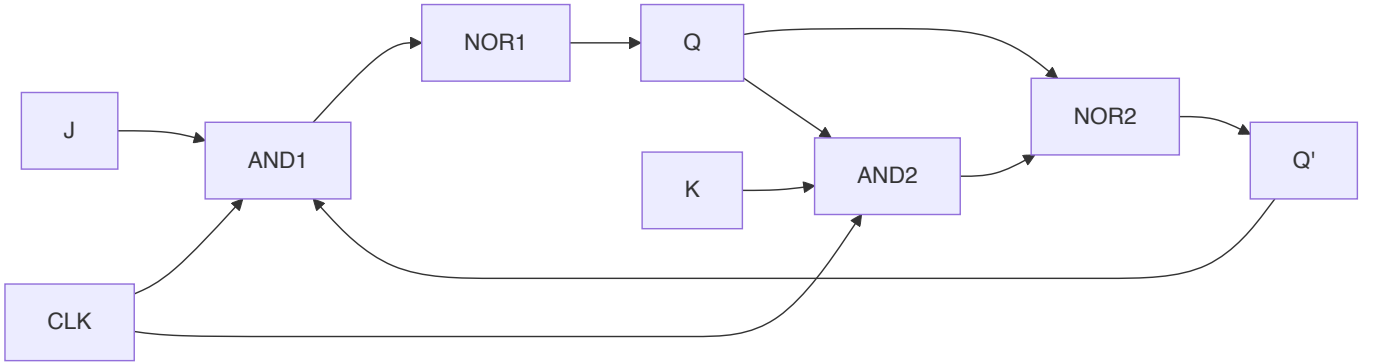
યાદરાખવાની ટિપ: "Behavior, Structure, Physics at All Levels"

પ્રશ્ન 4(બ OR) [4 ગુણ]

CMOS ઇન્વર્ટરનો ઉપયોગ કરીને clocked JK latch (NOR ગેટ) અમલ કરો

જવાબ:

JK latch toggle ક્ષમતા સાથે SR latch ની પ્રતિબંધિત સ્થિતિ દૂર કરે છે.

આકૃતિ:**સત્ય કોષ્ટક:**

J	K	Q(next)	ઓપરેશન
0	0	Q	Hold
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	Q'	Toggle

- ટોગલ મોડ: $J=K=1$ આઉટપુટ સ્થિતિ ફ્લિપ કરે છે
- ક્લોક એનેબલ: માત્ર $CLK=1$ હોય ત્યારે જ સક્રિય
- ફીડબેક: ઇનપુટ્સ સક્ષમ કરવા માટે વર્તમાન આઉટપુટ વાપરે છે

યાદરાખવાની ટિપ: "JK Toggles, No Forbidden State"

પ્રશ્ન 4(ક OR) [7 ગુણ]

લિથોગ્રાફી, એચિંગ, જમાવટ, ઓક્સિડેશન, આયન પ્રત્યારોપણ, પ્રસરણ જેવા શબ્દો સમજાવો

જવાબ:

Integrated circuits બનાવવા માટે આવશ્યક semiconductor fabrication processes.

પ્રક્રિયા	હેતુ	પદ્ધતિ
લિથોગ્રાફી	પેટર્ન ટ્રાન્સફર	માસ્ક દ્વારા UV exposure
એચિંગ	મેટેરિયલ રિમૂવલ	ભીના/સૂકા રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ
જમાવટ	લેયર ઉમેરો	CVD, PVD, sputtering
ઓક્સિડેશન	ઇન્સ્યુલેટર વૃદ્ધિ	થર્મલ/પ્લાઝ્મા ઓક્સિડેશન
આયન પ્રત્યારોપણ	ડોપિંગ પરિચય	ઉચ્ચ-ઊર્જા આયન બોમ્બાર્ડમેન્ટ
પ્રસરણ	ડોપન્ટ વિતરણ	ઉચ્ચ તાપમાને ફેલાવો

- પેટર્ન વ્યાખ્યા: લિથોગ્રાફી ડિવાઇસ લક્ષણો બનાવે છે
- પસંદગીયુક્ત રિમૂવલ: એચિંગ અનચાહેલ મેટેરિયલ દૂર કરે છે
- લેયર બિલ્ડિંગ: જમાવટ જરૂરી મેટેરિયલ ઉમેરે છે
- ડોપિંગ કંટ્રોલ: પ્રત્યારોપણ અને પ્રસરણ junctions બનાવે છે
- ગુણવત્તા નિયંત્રણ: દરેક પગલું અંતિમ ડિવાઇસ પરફોર્મન્સને અસર કરે છે

યાદરાખવાની ટિપ: "Light Etches Deposited Oxides, Ions Diffuse"

પ્રશ્ન 5(અ) [3 ગુણ]

વેરિલોગની મદદથી 2 ઇનપુટ XNOR ગેટને અમલમાં મૂકો

જવાબ:

XNOR ગેટ ઇનપુટ્સ સમાન હોય ત્યારે ઊંચો આઉટપુટ આપે છે.

```
module xnor_gate(
    input a, b,
    output y
);
    assign y = ~(a ^ b);
endmodule
```

- **લોજિક ફંક્શન:** $Y = (A \oplus B)' = A'B' + AB$
- **સત્ય કોષ્ટક:** ઇનપુટ્સ મેચ થાય ત્યારે આઉટપુટ ઊંચો
- **ઉપયોગ:** સમાનતા તુલનાકાર, પેરિટી ચેકર

યાદરાખવાની ટિપ: "XNOR Equals Equal Inputs"

પ્રશ્ન 5(બ) [4 ગુણ]

વેરિલોગમાં CASE સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને એનકોડર (8:3) અમલ કરો

જવાબ:

પ્રાયોરિટી એનકોડર 8-બિટ ઇનપુટને 3-બિટ બાઇનરી આઉટપુટમાં રૂપાંતરિત કરે છે.

```
module encoder_8to3(
    input [7:0] in,
    output reg [2:0] out
);
    always @(*) begin
        case(in)
            8'b00000001: out = 3'b000;
            8'b00000010: out = 3'b001;
            8'b00000100: out = 3'b010;
            8'b00001000: out = 3'b011;
            8'b00010000: out = 3'b100;
            8'b00100000: out = 3'b101;
            8'b01000000: out = 3'b110;
            8'b10000000: out = 3'b111;
            default: out = 3'b000;
        endcase
    end
endmodule
```

- **વન-હોટ એન્કોડિંગ:** માત્ર એક ઇનપુટ બિટ ઊંચો હોવો જોઈએ
- **પ્રાયોરિટી સ્કેચર:** ઊંચા બિટ્સ પ્રાધાન્ય લે છે
- **ડિફોલ્ટ કેસ:** અમાન્ય ઇનપુટ સંયોજનો સંભાળે છે

ચાદરાખવાની ટિપ: "One Hot Input, Binary Output"

પ્રશ્ન 5(ક) [7 ગુણ]

યોગ્ય ઉદાહરણો સાથે વેરિલોગમાં કેસ સ્ટેટમેન્ટ સમજાવો

જવાબ:

CASE સ્ટેટમેન્ટ expression value આધારે મલ્ટિ-વે બ્રાન્ચિંગ આપે છે.

સિન્ટેક્સ:

```
case (expression)
  value1: statement1;
  value2: statement2;
  default: default_statement;
endcase
```

ઉદાહરણ 1 - 4:1 MUX:

```
module mux_4to1(
  input [1:0] sel,
  input [3:0] in,
  output reg out
);
  always @(*) begin
    case(sel)
      2'b00: out = in[0];
      2'b01: out = in[1];
      2'b10: out = in[2];
      2'b11: out = in[3];
    endcase
  end
endmodule
```

ઉદાહરણ 2 - 7-સેગમેન્ટ ડિકોડર:

```
case(digit)
  4'h0: segments = 7'b1111110;
  4'h1: segments = 7'b0110000;
  4'h2: segments = 7'b1101101;
  default: segments = 7'b0000000;
endcase
```

વેરિઅન્ટ	સિન્ટેક્સ	ઉપયોગ કેસ
case	case(expr)	સંપૂર્ણ મેચિંગ
casex	casex(expr)	ડોન્ટ કેર (X)
casez	casez(expr)	હાઈ-Z (Z)

- કોમ્બિનેશનલ લોજિક: always @(*) બ્લોક વાપરો
- સિક્વેન્શિયલ લોજિક: always @(posedge clk) વાપરો
- ડિફોલ્ટ કેસ: સિન્ટેક્સમાં લેયેસ અટકાવે છે
- પેરેલલ ઇવેલ્યુએશન: બધા કેસ એકસાથે ચકાસાય છે

યાદરાખવાની ટિપ: "CASE Chooses Actions Systematically Everywhere"

પ્રશ્ન 5(અ OR) [3 ગુણ]

વેરિલોગ કોડનો ઉપયોગ કરીને full subtractor અમલ કરો

જવાબ:

Full subtractor borrow input અને output સાથે બાઇનરી બાદબાકી કરે છે.

```
module full_subtractor(
    input a, b, bin,
    output diff, bout
);
    assign diff = a ^ b ^ bin;
    assign bout = (~a & b) | (~a & bin) | (b & bin);
endmodule
```

સત્ય કોષ્ટક:

A	B	Bin	Diff	Bout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
1	1	1	1	1

- અંતર: ત્રણેય ઇનપુટ્સનો XOR
- ઉધાર: $A < (B + \text{Bin})$ હોય ત્યારે ઉત્પન્ન થાય છે

યાદરાખવાની ટિપ: "Subtract Borrows When Insufficient"

પ્રશ્ન 5(બ OR) [4 ગુણ]

વેરિલોગમાં Behavioural મોડેલિંગ શૈલીનો ઉપયોગ કરીને JK flipflop અમલ કરો

જવાબ:

Behavioral modeling વાપરીને toggle ક્ષમતા સાથે JK flip-flop.

```
module jk_flipflop(
    input j, k, clk, reset,
    output reg q, qbar
);
    always @(posedge clk or posedge reset) begin
        if(reset) begin
            q <= 1'b0;
            qbar <= 1'b1;
        end
        else begin
            case({j,k})
                2'b00: q <= q;           // Hold
                2'b01: q <= 1'b0;        // Reset
                2'b10: q <= 1'b1;        // Set
                2'b11: q <= ~q;         // Toggle
            endcase
            qbar <= ~q;
        end
    end
endmodule
```

- બિહેવિયરલ શૈલી: ફ્લિક્શનનું વર્ણન કરે છે, સ્ટ્રક્ચરનું નહીં
- સિંક્રોનસ રીસેટ: કલોક એજ પર રીસેટ
- નોન-બ્લોકિંગ અસાઇનમેન્ટ: clocked always block માં <= વાપરો

યાદરાખવાની ટિપ: "JK Behavior: Hold, Reset, Set, Toggle"

પ્રશ્ન 5(ક OR) [7 ગુણ]

ઉદાહરણ આપીને વિવિધ વેરિલોગ મોડેલિંગ શૈલી સમજાવો

જવાબ:

વેરિલોગ અલગ અલગ abstraction levels માટે ત્રણ મોડેલિંગ શૈલીઓ આપે છે.

શૈલી	એબ્સ્ટ્રેક્શન	વર્ણન	કન્સ્ટ્રક્ટ્સ
Behavioral	ઊંચી	ફ્લિક્શનનું વર્ણન કરે છે	always, if-else, case
Dataflow	મધ્યમ	ડેટા હલચલનું વર્ણન કરે છે	assign, operators
Structural	નીચી	કનેક્શનનું વર્ણન કરે છે	module instantiation

1. બિહેવિયરલ મોડેલિંગ:

સર્કિટ શું કરે છે તેનું વર્ણન કરે છે, કેવી રીતે બનાવેલ છે તે નહીં.

```
// 4-બિટ કાઉન્ટર
module counter(
    input clk, reset,
    output reg [3:0] count
);
    always @(posedge clk or posedge reset) begin
        if(reset)
            count <= 4'b0000;
        else
            count <= count + 1;
    end
endmodule
```

2. ડેટાફ્લો મોડેલિંગ:

કોમ્બિનેશનલ લોજિક માટે સતત અસાઇનમેન્ટ વાપરે છે.

```
// 4-બિટ એડર
module adder_4bit(
    input [3:0] a, b,
    input cin,
    output [3:0] sum,
    output cout
);
    assign {cout, sum} = a + b + cin;
    assign overflow = (a[3] & b[3] & ~sum[3]) |
        (~a[3] & ~b[3] & sum[3]);
endmodule
```

3. સ્ટ્રક્ચરલ મોડેલિંગ:

નીચલા-સ્તરના મોડ્યુલો instantiate અને કનેક્ટ કરે છે.

```
// હાફ એડર વાપરીને ફુલ એડર
module full_adder(
    input a, b, cin,
    output sum, cout
);
    wire s1, c1, c2;

    half_adder ha1(.a(a), .b(b), .sum(s1), .carry(c1));
    half_adder ha2(.a(s1), .b(cin), .sum(sum), .carry(c2));

    assign cout = c1 | c2;
endmodule

module half_adder(
    input a, b,
    output sum, carry
);
```

```
);
    assign sum = a ^ b;
    assign carry = a & b;
endmodule
```

તુલના કોષ્ટક:

પાસાં	Behavioral	Dataflow	Structural
જટિલતા	ઉચ્ચ-સ્તર	મધ્યમ-સ્તર	નીચલા-સ્તર
વાંચનીયતા	સૌથી વાંચવા યોગ્ય	મધ્યમ	સૌથી ઓછી વાંચવા યોગ્ય
સિન્થેસિસ	ટૂલ આધારિત	સીધી	સ્પષ્ટ
ડિઝાઇનિંગ	કઠિન	મધ્યમ	સરળ
પુનઃઉપયોગ	ઊંચો	મધ્યમ	ઊંચો

મિશ્રિત મોડેલિંગ ઉદાહરણ:

```
module cpu_alu(
    input [7:0] a, b,
    input [2:0] opcode,
    input clk,
    output reg [7:0] result
);
    // બિહેવિયરલ: કંટ્રોલ લોજિક
    always @(posedge clk) begin
        case(opcode)
            3'b000: result <= add_result;
            3'b001: result <= sub_result;
            3'b010: result <= and_result;
            default: result <= 8'h00;
        endcase
    end

    // ડેટાફ્લો: અંકગણિત ઓપરેશન્સ
    wire [7:0] add_result = a + b;
    wire [7:0] sub_result = a - b;
    wire [7:0] and_result = a & b;

    // સ્ટ્રક્ચરલ: સમર્પિત અંકગણિત યુનિટ્સ instantiate કરી શકાય
endmodule
```

ડિઝાઇન માર્ગદર્શિકા:

- **બિહેવિયરલ:** જટિલ કંટ્રોલ લોજિક, સ્ટેટ મશીન માટે વાપરો
- **ડેટાફ્લો:** સરળ કોમ્બિનેશનલ લોજિક માટે વાપરો
- **સ્ટ્રક્ચરલ:** હાયરાર્કિકલ ડિઝાઇન્સ, IP integration માટે વાપરો

- **મિશ્રિત અભિગમ:** શ્રેષ્ઠ ડિઝાઇન માટે શૈલીઓને જોડો

સિમ્યુલેશન વિ સિન્થેસિસ:

- **બિહેવિયરલ:** અપેક્ષા મુજબ synthesize નહીં થઈ શકે
- **ડેટાફ્લો:** સીધી હાર્ડવેર મેપિંગ
- **સ્ટ્રક્ચરલ:** બાંધઘરીકૃત સિન્થેસિસ મેથ

યાદરાખવાની ટિપ: "Behavior Describes, Dataflow Assigns, Structure Connects"